



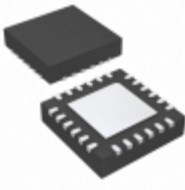




	<p>SI3407DV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3407DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3407DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 65645 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3407DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	65645 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 8A (Tc) 2W (Ta), 4.2W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 4.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 7.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1670pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3407DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3407DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3407DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3407DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3406FBC2-KIT Energy Micro (Silicon Labs) EVAL KIT FOR SI3406 NONISO FLYBA</p>	 <p>SI34062-A-GMR Energy Micro (Silicon Labs) HIGH-EFFICIENCY SWITCHING REGULA</p>	 <p>SI3406FBC3-KIT Energy Micro (Silicon Labs) EVAL KIT FOR SI3406 NONISO FLYBA</p>	 <p>SI34062-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) HIGH-EFFICIENCY SWITCHING REGULA</p>
 <p>SI3410DV Vishay Vishay SOT-23-6</p>	 <p>SI3407DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3410DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3407-TP Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>

heiße Teile

Mehr

SI3230M-KT	SI3232-GQ	SI3233-FM	SI3238-FM	SI3239-C-FM
SI3239-C-FMR	SI3239-E-ZM3	SI3239-E-ZM3R	SI3239-FM	SI3239-GM
SI3239-ZM3	SI32391-B-FM	SI32392-B-FM	SI32392-B-FMR	SI32392-FM
SI3240CS	SI3241-D-FQR	SI3241-FQ	SI3241-GQ	SI32919-A-FS
SI32919-A-FSR	SI32919A-FSR	SI3402-A-GMR	SI3402-GM	SI3403DV-T1-GE3
SI3407DV-T1-E3	SI3407DV-T1-GE3	SI3407DV-T1-GE3	SI3410DV-T1-E3	SI3410DV-T1-E3
SI3410DV-T1-GE3	SI3410DV-T1-GE3	SI3417DV-T1-GE3	SI3417DV-T1-GE3	SI3420DV-T1-GE3
SI3421DV-T1-GE3	SI3421DV-T1-GE3	SI3422DV	SI3422DV-T1	SI3422DV-T1-GE3
SI3424BDV	SI3424BDV-T1-E3	SI3424BDV-T1-E3	SI3424BDV-T1-GE3	SI3424BDV-T1-GE3
SI3424CDV	SI3424CDV-T1-E3	SI3424CDV-T1-GE3	SI3424CDV-T1-GE3	SI3424DV-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited